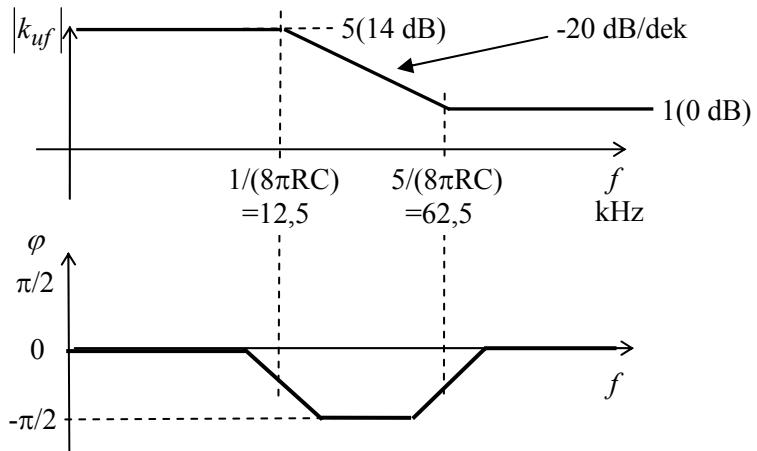


EGZAMIN (w rozwiązańach podaj ostateczny wzór i obliczoną wartość)

1.	<p>Odp.</p> $h_{21} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{\Delta U_{WY} / R_C}{(\Delta E - \Delta U_{WE}) / R_B}$ $= 256$ $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{(U_{CC} - U_{WY})R_B}{R_C(E - U_{WE})} = 200$	<p>W układzie jak na rysunku wykonano pomiary dla różnych wartości napięcia E_G:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>E [V]</th> <th>U_{WE} [V]</th> <th>U_{WY} [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.738</td> <td>0.688</td> <td>3.944</td> </tr> <tr> <td>0.720</td> <td>0.680</td> <td>4.200</td> </tr> </tbody> </table> <p>Oblicz współczynniki wzmocnienia prądowego tranzystora:</p> <p>(a) statyczny β [1p] (b) dynamiczny (różniczkowy) h_{21} [1p]</p>	E [V]	U_{WE} [V]	U_{WY} [V]	0.738	0.688	3.944	0.720	0.680	4.200			
E [V]	U_{WE} [V]	U_{WY} [V]												
0.738	0.688	3.944												
0.720	0.680	4.200												
2.	<p>Odp.</p> $P_{Z_{\max}} = U_Z I_{Z_{\max}} = \frac{U_Z^2}{R_{O_{\min}}} = 1\text{W}$ <p>(Przy rozwarciu wyjścia dioda przejmuje prąd z obciążenia.)</p> <p>Wartość maksymalna tego prądu $U_Z/R_{O_{\min}}$ nie może przekroczyć maksymalnego prądu diody. Zatem jest $I_{Z_{\max}} = U_Z/R_{O_{\min}}$)</p>	<p>Wyznacz moc admisijną $P_{Z_{\max}}$ diody jeśli rezystancja obciążająca może się zmieniać w granicach $100\Omega < R_O < \infty$. W obliczeniach przyjmij następujące parametry diody Zenera: $U_Z = 10\text{ V}$, $r_Z = 0\text{ }\Omega$. (Moc admisijną to maksymalna moc, która może wydzielić się w przyrządzie.) [2p]</p>												
3.	<p>Oblicz wartości napięcia U_{CE} odpowiadające wartościom napięcia u_{WE}. [3p]</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>u_{WE} [V]</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U_{CE} (wzór)</td> <td>$U_{CE} = U_{CC}$ (zatkany)</td> <td>$U_{CE} = U_{CC} - R_C \beta (u_{WE} - 0.7\text{V}) / R_B$ (aktywny)</td> <td>$U_{CE_{\text{nasas}}}$ (nasycony)</td> </tr> <tr> <td>U_{CE} [V] (wartość)</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>0.2</td> </tr> </tbody> </table>	u_{WE} [V]	0	1	2	U_{CE} (wzór)	$U_{CE} = U_{CC}$ (zatkany)	$U_{CE} = U_{CC} - R_C \beta (u_{WE} - 0.7\text{V}) / R_B$ (aktywny)	$U_{CE_{\text{nasas}}}$ (nasycony)	U_{CE} [V] (wartość)	5	2	0.2	
u_{WE} [V]	0	1	2											
U_{CE} (wzór)	$U_{CE} = U_{CC}$ (zatkany)	$U_{CE} = U_{CC} - R_C \beta (u_{WE} - 0.7\text{V}) / R_B$ (aktywny)	$U_{CE_{\text{nasas}}}$ (nasycony)											
U_{CE} [V] (wartość)	5	2	0.2											
4.	<p>Uzupełnij zdania: Tranzystory T_1 T_2 tworzą układ [1p]lustra prądowego..... Tranzystor T_3 pracuje w układzie [1p]wzmacniacza WE (OE)....</p> <p>Oblicz $u_{wy}(t)$ jeśli $u_{we}(t) = 15\sin(\omega t)\text{ mV}$. Obliczenia przeprowadź dla średnich częstotliwości (przyjmij $\eta = 1$, $U_T = 25\text{mV}$) [2p]</p> $u_{wy}(t) = -g_m R_C u_{we}(t) = -40 I_A R_C u_{wy}(t) = -3.6 \sin(\omega t) \text{ V}$													
5.	<p>$k_{u0} = -g_m R_D R_0 = -6$</p> <p>$C_{we} = C_{gs} + (1 + k_{u0}) C_{gd} = 1600\text{pF}$</p> <p>$f_g \equiv 1/(2\pi C_{we} R_g) = 170\text{kHz}$</p>	<p>W układzie wzmacniacza OS transkonduktancja tranzystora w punkcie pracy wynosi $g_m = 1.5\text{ mS}$. Oblicz wzmocnienie na środku pasma k_{u0} [1p] oraz górną częstotliwość graniczną f_g [1p]. W obliczeniach przyjmij $r_{ds} = \infty$, $C_{gs} = C_{gd} = 200\text{ pF}$ oraz że rezystancja wewnętrzna źródła napięcia zmiennego E_g jest równa $R_g = 600\text{ }\Omega$.</p> <p>Odpowiedz na pytania: -jak nazywa się tranzystor zastosowany w układzie? [0,5p] n-JFET</p> <p>-jak nazywa się układ polaryzacji tranzystora? [0,5p] automatyczna polaryzacja bramki</p> <p>Oblicz napięcie U_{GD} i określ zakres pracy tranzystora jeśli wiadomo, że $I_D = 9/5\text{mA}$ a napięcie odcięcia wynosi $U_P = -4\text{V}$? [1p]</p> $U_{GD} = -(E_{DD} - I_D R_D) = -(15 - 9/5 \cdot 5) \text{V} = -6\text{V}$ <p>zakres pracy:nasycenie.....bo.....$U_{GB} < U_P$....</p>												

6.	<p>Odp. Wtórnik emiterowy: $k_{u0} \approx 1$</p> <p>$g_m = 40I = 60\text{mS}$</p> <p>$h_{11} = h_{21}/g_m = 2\text{k}\Omega$</p> <p>$R_{wy} = (h_{11} + R_B)/(1 + h_{21}) = 50\Omega$</p>	Oblicz (w przybliżeniu) wzmacnienie k_{u0} [1p] oraz rezystancję wyjściową R_{wy} [2p] układu. Obliczenia przeprowadź dla średnich częstotliwości. Przyjmij wartość $h_{21}=120$.
7.	<p>Odp.</p> <p>$I_E = 2\text{mA}$, $k_{ur}^+ = \frac{1}{2} g_m R_C = 40 \frac{I_E}{4} R_C = 40$,</p> <p>$k_{us}^+ = k_{ur}^+ / 10^{CMMR^+/20} = 0.4$</p> <p>$u_{wy-b}(t) = k_{ur}^+ u_{we}(t) = 0.4 \sin(\omega t) \text{ V}$,</p> <p>$u_{wy-a}(t) = k_{us}^+ u_{we}(t) = 4 \sin(\omega t) \text{ mV}$</p>	Oblicz w przybliżeniu napięcie $u_{wy}(t)$ dla obu pozycji przełącznika jeśli $u_{we}(t) = 10\sin(\omega t) \text{ mV}$ oraz wiadomo, że współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego dla wyjścia nieodwracającego $CMMR^+ = 40\text{dB}$. Obliczenia przeprowadź dla średnich częstotliwości. [4p]
8.	<p>Odp.</p> <p>$k_{uf}(j\omega) = 1 + \frac{Z_2}{Z_1} =$</p> $1 + \frac{4R \parallel (1/j\omega C)}{R} =$ $5 \frac{1 + j\omega 4RC/5}{1 + j\omega 4RC}$	Oblicz [1p] i narysuj logarytmiczną charakterystykę amplitudową [0:2p] i fazową wzmacniacza [0:2p]. Na wykresie zaznacz istotne wielkości: wzmacnienie i fazę dla $\omega \rightarrow \infty$ i $\omega \rightarrow 0$, częstotliwości graniczne, nachylenie charakterystyki amplitudowej. Przyjmij, że wzmacniacz operacyjny jest idealny.



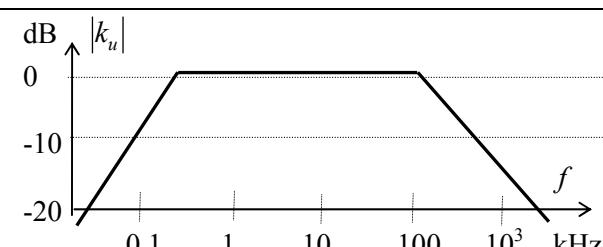
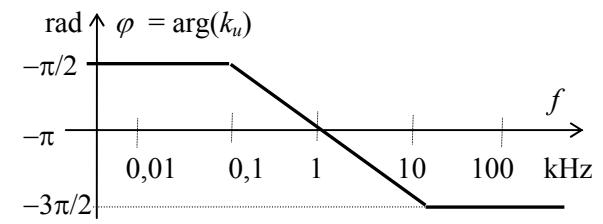
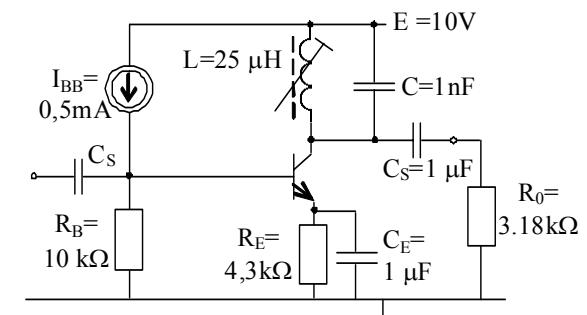
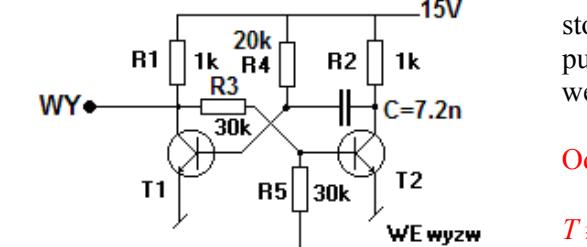
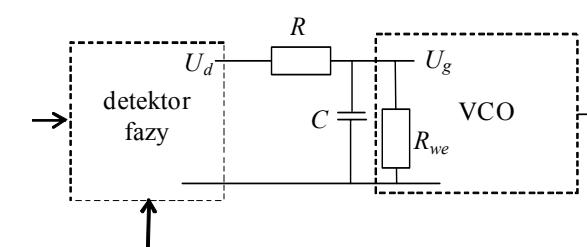
Oblicz górną częstotliwość graniczną jeśli zastosowany WO ma pole wzmacnienia GB = 1MHz [1p]

$$\beta_{w.cz.} \equiv \beta(f > 62.5\text{kHz}) = 1, f_g = \text{GB} \beta_{w.cz.} = \text{GB} = 1\text{MHz}$$

<p>9.</p>	<p>Dla układu przerzutnika Bowesa wyznacz wartość U_x napięcia wejściowego, dla której przerzutnik zmienia stan z niskiego na wysoki (rysunek). W obliczeniach przyjmij, że dla obu tranzystorów współczynnik $\beta \gg 1$. [2p]</p>
<p>$U_x = U_{wy2} + 0.7V = 2.7V$</p>	

<p>10.</p>	<p>Uzupełnij zdania: Linią ciągłą oznaczono charakterystykę [0.5p] ... $u_{C2}(u_{B1})$ Linią przerywaną oznaczono charakterystykę [0.5p] ... $u_{C1}(u_{B1})$.... Oblicz wartości napięć U_x, U_{y1}, U_{y2}, U_M zaznaczone w polu charakterystyk przejściowych układu. W obliczeniach przyjmij $U_{BCP} = 0.5V$. [2p]</p>
<p>Odp. $U_x = U_{CC} = 5V$ $U_{y1} = U_{CC} - R_{C2}I = 3.5V$ $U_{y2} = U_{CC} - R_{C1}I = 2V$ $U_M = U_{y2} + U_{BCP} = 2.5V$</p>	

<p>11.</p>	<p>Odp.</p> <p>(a) $I_E = (IR_1 - 0.7V)/Re = 2mA$</p> <p>(b) $k_{ur}^+ = g_m R_c / 2 = 40 I_E R_c / 4 = 100$ $U_{wy} = k_{ur}^+ U_n = 1V$</p> <p>(c) $U_{ac} = 2U_m = 2V$ (wzm. odwracający o wzm. $k_u = 2 + \text{wtórnik emiterowy}$), $U_{dc} = IR_1 - 0.7V = 5V$ $m = U_{ac}/U_{dc} \cong 0.4$</p>
<p>(a) Oblicz wartość prądu I_E (podaj wzór i wartość) [1p] (b) Oblicz amplitudę U_{wy} napięcia na wyjściu modulatora jeśli amplituda napięcia modulowanego (nośnej) na wejściu układu $U_n = 10mV$, a amplituda sygnału modulującego $U_m = 0$. [1p] (c) Oblicz głębokość modulacji m jeśli $U_m = 1V$. [Wskazówka: głębokość modulacji jest równa stosunkowi amplitudy napięcia modulującego pojawiącego się na Re (U_{ac}) do napięcia stałego na tym rezystorze $m = U_{ac}/U_{dc}$]. [3p].</p>	

12.	<p>Zmierzono charakterystyki częstotliwościowe wzmacniacza.</p> <p>a) Któża z podanych niżej transmitancji członu sprzężenia zwrotnego β zapewni, że układ stanie się generatorem po zamknięciu pętli s.z.? [1p]</p> <table border="1" data-bbox="174 269 745 314"> <tr> <td>$\beta = 0$</td><td>$\beta = -1$</td><td>$\beta = 1$</td><td>$\beta = -1/20$</td><td>$\beta = 1/20$</td></tr> </table> <p>b) Któża z poniższych warunków będzie spełniać częstotliwość f_g powstałego generatora [1p]</p> <table border="1" data-bbox="174 404 745 449"> <tr> <td>$f_g \ll 10^3 \text{Hz}$</td><td>$f_g \approx 10^3 \text{Hz}$</td><td>$f_g \gg 10^3 \text{Hz}$</td></tr> </table> <p>c) Jaki w przybliżeniu będzie kształt generowanego sygnału [1p]</p> <table border="1" data-bbox="174 494 698 583"> <tr> <td>wykładniczy</td><td>logarytmiczny</td></tr> <tr> <td>sinusoidalny</td><td>prostokątny</td></tr> </table> <p>(zaznacz odpowiednią odpowiedź)</p>	$\beta = 0$	$\beta = -1$	$\beta = 1$	$\beta = -1/20$	$\beta = 1/20$	$f_g \ll 10^3 \text{Hz}$	$f_g \approx 10^3 \text{Hz}$	$f_g \gg 10^3 \text{Hz}$	wykładniczy	logarytmiczny	sinusoidalny	prostokątny	 
$\beta = 0$	$\beta = -1$	$\beta = 1$	$\beta = -1/20$	$\beta = 1/20$										
$f_g \ll 10^3 \text{Hz}$	$f_g \approx 10^3 \text{Hz}$	$f_g \gg 10^3 \text{Hz}$												
wykładniczy	logarytmiczny													
sinusoidalny	prostokątny													
13.		<p>Oblicz częstotliwość rezonansową f_0 oraz 3dB szerokość pasma B wzmacniacza selektywnego. W obliczeniach przyjmij, że cewka jest idealna ($Q_L = \infty$), a impedancja wyjściowa tranzystora jest nieskończona, $g_{ce} = 0$. [2p]</p> <p>Odp.</p> $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx 1 \text{MHz}$ $Q = 2\pi f_0 C R_0 \approx 20,$ $B = 2\Delta f_{3\text{dB}} = f_0/Q \approx 50 \text{ kHz}.$												
14.		<p>Przerutnik jest wyzwalany przebiegiem impulsowym o częstotliwości $f = 1 \text{kHz}$. Oblicz czas trwania pojedynczego impulsu, T, oraz współczynnik wypełnienia przebiegu wyjściowego k. (k = "czas w stanie wysokim"/okres). [2p]</p> <p>Odp.</p> $T \approx R_4 C \ln 2 = 0.1 \text{ms}$ $k = Tf = 0.1$												
15.	<p>W układzie pętli PLL zastosowano detektor fazy o charakterystyce $U_d = 2\sin(\varphi) \text{ V}$, filtr pętlowy RC o z elementami $R = 10 \text{k}\Omega$ i $C = 2.4 \text{nF}$ oraz generator VCO o częstotliwości własnej $f_0 = 10.7 \text{ MHz}$ i współczynniku przestrajania $K_g = 3 \text{MHz/V}$. Oblicz zakresy trzymania Δf_L i chwytyania Δf_C synchronizacji jeśli wiadomo, że wejście generatora VCO obciąża filtr rezystancją $R_{we} = 20 \text{k}\Omega$ (rysunek). [4p]</p> 	<p>Transmitancją filtra z obciążeniem</p> $H(j\omega) \equiv \frac{U_g}{U_d} = \frac{R_{we}}{R_{we} + R} \frac{1}{1 + j\omega(R_{we} \parallel R)C}$ $H(0) = R_{we}/(R + R_{we}) = 0.33$ <p>zakres trzymania synchronizacji:</p> $\Delta f_L = U_{dmax} H(0) K_g = 2 \text{MHz},$ <p>stała czasowa filtra z obciążeniem (patrz $H(j\omega)$)</p> $\tau = (R \parallel R_{we})C = 16 \mu\text{s},$ <p>cz. graniczna filtra pętlowego $f_1 = 1/(2\pi\tau) = 10 \text{kHz}$,</p> <p>zakres chwytyania synchronizacji:</p> $\Delta f_C = (\Delta f_L f_1)^{1/2} = 144 \text{kHz}$												